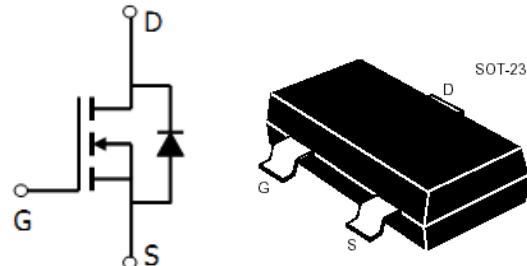


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current continuous 漏極電流-連續	I_{DR}	2.3	A
Drain Current-pulsed 漏極電流-脉冲	I_{DRM}	5	A

■THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	900	mW
		3.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	150	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	150°C, -55 to +150°C	



东莞市宇芯电子有限公司
DONGGUAN YUSHIN ELECTRONICS CO.,LTD
电话: 0769-89268116 传真: 0769-89268117

GM2308S

■DEVICE MARKING 打標

GM2308S=E8S

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D = 250\mu\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$)	BV_{DSS}	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D = 250\mu\text{A}$, $V_{GS} = V_{DS}$)	$V_{GS(\text{th})}$	1	—	3	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{SD} = 1\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 60\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻($I_D = 2.3\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$) ($I_D = 2\text{A}$, $V_{GS} = 4.5\text{V}$)	$R_{DS(\text{ON})}$	—	—	156 192	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	—	550	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容($V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	—	125	pF
Turn-ON Time 开啓時間 ($V_{DS} = 30\text{V}$, $I_D = 200\text{mA}$, $R_{\text{GEN}} = 25\Omega$)	$t_{(\text{on})}$	—	—	40	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ($V_{DS} = 30\text{V}$, $I_D = 200\text{mA}$, $R_{\text{GEN}} = 25\Omega$)	$t_{(\text{off})}$	—	—	80	ns

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
- Pulse Width≤300 μs ; Duty Cycle≤2.0%.



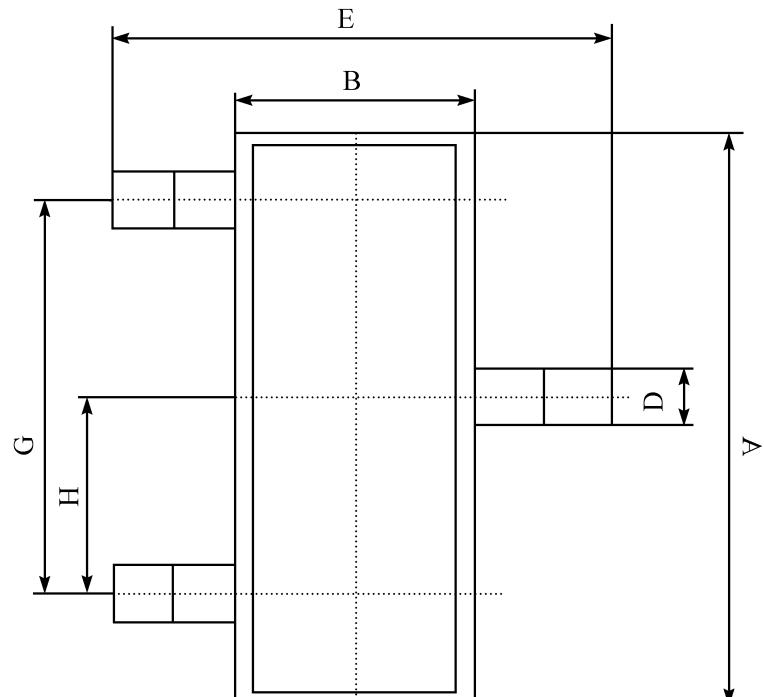
宇芯微
YSMICRO

东莞市宇芯电子有限公司
DONGGUAN YUSHIN ELECTRONICS CO.,LTD
电话: 0769-89268116 传真: 0769-89268117

GM2308S

■DIMENSION 外形封装尺寸

单位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

